

Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, выпуск 6

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия) Гурбанов Г.Р., Адыгезалова М.Б. Характер взаимодействия в системе $\text{SnSb}_2\text{Te}_4\text{-SnBi}_2\text{Te}_4$ и термоэлектрические свойства твердых растворов $(\text{SnSb}_2\text{Te}_4)_{1-x}(\text{SnBi}_2\text{Te}_4)_x$	483
Электронные свойства полупроводников Бахадирханов М.К., Исамов С.Б., Зикриллаев Н.Ф., Турсунов М.О. Аномальные фотоэлектрические явления в кремнии с нанокластерами атомов марганца	489
Рабаданов М.Р., Степуренко А.А., Гумметов А.Э., Исмаилов А.М. Температурная зависимость проводимости нитевидных кристаллов теллура	493
Nemov S., Kostyuk O., Dzundza B., Chernyak L., Dashevsky Z. High Perfection Bulk and Film Thermoelectrics Based on PbTe Doped by In	499
Abraham R.J.S., Shuman V.B., Portsel L.M., Lodygin A.N., Astrov Yu.A., Abrosimov N.V., Pavlov S.G., Hubers H.-W., Simmons S., Thewalt M.L.W. Thermal Activation of Valley-Orbit States of Neutral Magnesium in Silicon	500
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки Abdel Moez A., Salem M.A., Elmeleegi A., Elmandouh Z.S. Investigation of Structure, First Order Optical Susceptibility, Non-linear Optical, Electrical Susceptibility Results and IV Characterizations of Graphene Multilayer	501
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления Семакова А.А., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Черняев А.В., Кижаяев С.С., Стоянов Н.Д. Исследование вольт-амперных характеристик светодиодных гетероструктур на основе InAsSb в диапазоне температур 4.2-300 К	502
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники Fan Zhang, Черкова С.Г., Володин В.А. Формирование нанокристаллов германия в пленках $\text{GeO}[\text{SiO}_2]$ и $\text{GeO}[\text{SiO}]$	507
Нагалюк С.С., Мохов Е.Н., Казарова О.П., Бер Б.Я., Анисимов А.А., Бреев И.Д. Возникновение зеленой окраски в кристаллах AlN, выращенных на затравках SiC	513
Углеродные системы Морозов М.Ю., Моисеенко И.М., Коротченков А.В., Попов В.В. Замедление терагерцовых плазменных волн в конической структуре с графеном, накачиваемым с помощью оптических плазменных волн	518
Физика полупроводниковых приборов Тандоев А.Г., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н. Вольт-амперная характеристика мощных диодных структур с резкой асимметрией инжектирующей способности эмиттеров	524
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур Brella M., Taabouche A., Gharbi B., Gheriani R., Bouachiba Y., Bouabellou A., Serrar H., Touil S., Laggoune K., Boudissa M. Comparison of Thin Films of Titanium Dioxide Deposited by Sputtering and Sol-Gel Methods for Waveguiding Applications	533
Pradhan D., Kar J.P. Microstructural and Electronic Properties of Rapid Thermally Grown MoS_2/Silicon Hetero-Junctions with Various Process Parameters	534